⑲ 日本国特許庁(JP)

m特許出願公告

⑫特 許 公 報(B2)

庁内整理番号

平5-69420

®Int. Cl. 5

識別記号

❷❷公告 平成5年(1993)10月1日

G 03 F 7/039 7/004

503

7/029 H 01 L 21/027

7352-4M H 01 L 21/30

301 R 発明の数 1 (全7頁)

69発明の名称

優先権主張

ホトレジスト組成物およびtー置換オルガノメチルピニルアリール エーテル材料

釰特 願 昭61-223978

❸公 閉 昭62-115440

@昭62(1987) 5月27日

❷出 顧 昭61(1986)9月24日

0.37697804700

ス 51エステイー ストリート 10028

❷1985年9月27日❷米国(US)❸780,768

発 明 者 ジェームズ・ピンセン

ト・クリベロ

アメリカ合衆国、ニユーヨーク州、クリフトン・パーク、

カールトン・ロード、756番 アメリカ合衆国 アリゾナ 85044 フエニックス,サウ

⑦出 願 人 マイクロサイ,インコ

ーポレイテツド

19代理人 弁理士山本 秀策 審査官 深 津 弘

1

切特許請求の範囲

1 (A) 本質的に次式:

- (B) 有効量のカチオン性光開始剤および
- (C) 成分(A) 1 部当り10-95部の不活性有機溶剤

を含むホトレジスト組成物。

- 2 重合体が化学結合した4-t-ブトキシスチレン単位よりなる特許請求の範囲第1項記載のホトレジスト組成物。
- 5 3 重合体が化学結合した4-t-ブトキシーα -メチルスチレン単位よりなる特許請求の範囲第 1 項配載のホトレジスト組成物。
- 4 光閉始剤としてジアリールヨードニウム塩を 用いる特許請求の範囲第1項記載のホトレジスト 10 組成物。
 - 5 光開始剤としてトリアリールスルホニウム塩 を用いる特許請求の範囲第1項記載のホトレジス ト組成物。

[式中のRはCu-s)アルキル基およびCus-tu)ア

(2)

リール基よりなる群から選ばれる一価の基で、 R¹およびR²は同じか異なる一価のCu-x)アルキル 基で、R³は水素およびC₍₁₋₃₎アルキルから選ばれ る一価の基で、Rfは水素、C(1-2)アルキルおよび じか異なるC(1-a)アルキル基、Cℓ, Br, NO₂, CN, C(1-8)アルコキシおよびC(1-8)アルキルエス テルから選ばれ、aは0-2に等しい]のアルケ ニルアリールエーテル。

範囲第6項記載のアルケニルアリールエーテル。 4-t-プトキシ-α-メチルスチレンであ る特許請求の範囲第6項記載のアルケニルアリー ルエーテル。

範囲第6項記載のアルケニルアリールエーテル。 10 本質的に次式:

[式中のRはC(1-8)アルキル基およびC(6-14)ア リール基よりなる群から選ばれる一価の基で、 R¹およびR²は同じか異なる一価のCu-a)アルキル 基で、R3は水素およびCu-a)アルキルから選ばれ 30 る一価の基で、R⁴は水素、C₁₋₂アルキルおよび これらの組合せから選ばれる一価の基でR⁵は同 じか異なるC(1-n)アルキル基、Cℓ, Br, NO₂, CN, C(1-8)アルコキシおよびC(1-8)アルキルエス テルから選ばれ、aは0-2に等しい]の化学結 35 リール基よりなる群から選ばれる一価の基で、 合単位よりなる重合体。

発明の詳細な説明

発明の背景

種々の感光性重合体を種々の光増感剤と組合せ とが行われており、このような重合体の例とし て、メリル (Merrill) が米国特許第2948610号で アジド重合体を開示し、またミンスク (Minsk) が米国特許第2725372号でポリピニルアルコール の不飽和エステルを開示し、これらはそれぞれイ ーストマン・コダツク社 (Eastman Kodak) の ホトレジストKPRおよびKMERである。

イトウらの米国特許第4491628号に、tーブチ これらの組合せから選ばれる一価の基でR⁵は同 5 ルエステルや t ーブチルカーポネートなどの反復 側基を有するポリスチレンのような重合体を光開 始剤と組合せて用いることが開示されている。紫 外線に暴露すると酸が発生し、これがスチリルt ニプチルエステルまたはスチリルtープチルカー 7 4-t-プトキシスチレンである特許請求の 10 ポネートを対応する塩基可溶性フエノールに転化 する。増感剤の波長を変える増感剤をこのホトレ ジストに加えることもできる。イトウらのポジま たはネガ型ホトレジスト組成物は従来のホトレジ ストより著しく有利であるが、ポリーtープトキ 9 3-t-ブトキシスチレンである特許請求の 15 シカルボニルオキシスチレンまたは対応するボリ ーtープトキシカルポニルオキシーαーメチルス チレンを紫外線に暴露すると、二酸化炭素および イソブチレンの両方、すなわち過剰量の気体状副 生物が生成する。塩基水溶液に可溶な生成物また 20 はn-ヘキサンと塩化メチレンの混合物に可溶な 生成物に転化でき、しかも過剰量の気体状副生物 を発生しない、重合体材料を用いたポジまたはネ ガ型ホトレジスト組成物が得られれば望ましい。 本考案は、次式:

[式中のRはCu-s)アルキル基およびCo-14)ア R¹およびR²は同じか異なる一価のC(1-s)アルキル 基で、R³は水素およびCu-s)アルキルから選ばれ る一価の基で、R'は水素、C(1-2)アルキルおよび これらの組合せから選ばれる一価の基でR®は同 て用いて、紫外線照射時に重合体に架橋を起すこ 40 じか異なるC₁-s₁アルキル基、Cℓ, Br, NO₂, CN, C(1-1)アルコキシおよびC(1-1)アルキルエス テルから選ばれ、aは0-2に等しい]のt-置 換オルガノメチルピニルアリールエーテル、例え ばtープチルピニルアリールエーテルが重合で

25

(3)

特公 平 5-69420

5

き、得られる重合体が有効量のアリールオニウム 塩(後述)と組み合わせるとホトレジストとして 使用できることを見出してなしたものである。こ うして得られるホトレジストは、次式:

[式中のR³, R⁴, R⁵およびaは前配定袋の通り]の化学結合単位を多数有するポジ型ホトレジストに転化することができる。本質的に式(2)の化学結合単位よりなる塩基可溶性重合体を生成する 15 結果として、有利なことには、イソブチレンのような不飽和オレフインが生成し、イトウらのホトレジスト法で生じる二酸化炭素のような気体状副生物を余分に発生することはない。

本考案によれば、

(A) 本質的に次式:

[式中のR, R¹, R², R³, R⁴およびR⁵および a は前記定義の通り]の化学結合単位よりなるポリスチレン、

(B) 有効量のカチオン性光開始剤、および (C) 成分(A) 1 部当り10-95部の不活性有機溶剤 を含むホトレジスト組成物が提供される。

R, R¹, R²およびR⁵に含まれる一価のアルキル基は、例えば、メチル、エチル、プロピル、ブ 40 チル、ベンチル、ヘキシルであり、R³およびR⁴に含まれる一価の基は、例えば、水素またはRに含まれるC(1-3)アルキルである。そのほかにRはフエニル、トリル、キシリルまたはこれらの置換

されたものとなり得、一方R⁵はメトキシ、エト キシ、カルベトキシなどとなり得る。

本発明の実施にあたつて使用できるカチオン性 光開始剤は、例えばジアリールヨードニウム塩で 5 あり、具体的には下記のものがある。

35 アリールスルホニウム塩も含まれ、その具体例 には下記のものがある。

30

(4)

5

特公 平 5-69420

8

7

$$(CH_1 - C) \rightarrow S$$
 As F₆

本発明の実施にあたつて使用できる別のカチオ 15 ン性開始剤は、例えば次のものである。

光開始剤の有効量は、前述した成分(A), (B)および(C)のホトレジスト組成物の全重量に基づいて0.5-20重量%の光開始剤である。

式(1)に含まれる t ープチルピニルアリールエーテルの具体例には次のものがある。

40

(5)

特公 平 5-69420

9

10

式(1)の tーブチルアリールピニルエーテルを製

式(1)の t ープチルピニルアリールエーテルを本 質的に式(3)の化学結合単位よりなる重合体に重合 させるには、有効量の重合触媒、例えば過酸化べ ル、過酸化ラウロイル、過酸化ジクミル、tーブ チルペルオキシピパレート、過酸化プロピオニル などを用いて重合を行うことができる。重合触媒 の有効量は、触媒と式(1)の範囲内の t ープチルビ 5 重量%の触媒である。式(1)の t ープチルピニル アリールエーテルの重合は、窒素や貴ガスのよう な不活性雰囲気中で、不活性有機溶剤の存在下、 25℃-180℃の範囲の温度で行うことができる。 エン、水、エタノール、シクロヘキサン、キシレ ン、クロロペンゼン、ジメチルホルムアミド、イ ソプロピルアルコールなどが適用である。

本質的に式(3)の化学結合単位よりなる本発明の 機溶剤としては、例えば、1, 2-ジメトキシエ タン、セロソルプアセテート、シクロヘキサノ ン、プロピレングリコールメチルエーテルアセテ ート、クロロベンゼン、ジエチレングリコールジ 造する好適な方法は、例えば次の通りである。

メチルエーテル、塩化メチレン、1,2-ジクロ ロエタン、ジオキサンなどが適当である。

特定の実施態様では、増感剤を本質的に式(3)の ンゾイル、 2, 2 ーアゾピスイソブチロニトリ 25 化学結合単位よりなるホトレジストと組合せて用 いて、ホトレジストのスペクトル応答を長波長側 へずらすことができる。これらの増感剤は、本質 的に式(3)の化学結合単位よりなるポリスチレン、 光開始剤および有機溶剤よりなるホトレジスト組 ニルアリールエーテルとの重量に基づいて0.1- 30 成物の重量に基づいて、0.025-5重量%の量用 いることができる。これらの増感剤の例には、ア クリジンオレンジ、ベンゾフラビン、アントラセ ン、ペリレン、ルペレン、ペンゾフエノン、アン トラキノン、クリセン、アクリジンイエロー、 不活性有機溶剤としては、例えばベンゼン、トル 35 9,10-ジフエニルアントラセン、9-エトキシ アントラセン、ミヒラーケトン、ピレン、アント ロン、チオキサントンがある。

本発明のホトレジスト組成物では、波長227-600nm(ナノメータ) の紫外線を用いた場合に、 ホトレジスト組成物と組合せて用い得る不活性有 40 良好な結果が得られることを確かめた。しかし、 場合によつては、電子ピームやX線も使用でき る。ネガ型ホトレジストが望ましい場合には、ホ トレジストを適当な支持体に標準のスピンキャス ト法で塗布し、照射して酸触媒を遊離させた後、

(6)

特公 平 5-69420

11

希塩基水溶液の代りに有機溶剤の混合液、例えば nーヘキサンと塩化メチレンを用いることができ

当業者が本発明をうまく実施できるように、以 下に実施例を限定としてではなく例示として説明 5 体のガラス転移温度は103℃であつた。 する。部はすべて重量基準である。

実施例 1

窒素雰囲気下で激しくかきまぜながら、62.9g のマグネシウム金属切り屑に、十分なテトラヒド ロフランで切り屑をおおうようにして、滴加し た。発熱反応を外部冷却により制御して温度を60 ℃以下に保つた。発熱がやんだ後、反応混合物を れるまで加熱した。塩ー氷浴を用いて反応混合物 を0℃に冷却し、44g(0.23モル)のtープチルパ ーベンゾエートを80×1のテトラヒドロフランに溶 解した溶液を温度を0℃-5℃の間に維持するよ 2時間にわたつて温度を25℃まで上昇させた。次 に反応混合物を1000元の3%塩酸に注入した。生 成した油を200mのエチルエーテルで数回、水溶 液から抽出した。エーテル層を10%水酸化ナトリ になるまで洗つた。次にエーテル層を硫酸ナトリ ウム上で乾燥し、回転エパポレータを用いてエー テルを除去した。残つた黄白色の油に少量のアイ オノールを禁止剤として加え、生成物を分別蒸留 トキシスチレンを収率20%で得た。プロトン NMRスペクトルを記録した。これは生成物の構 造と一致していた。

元素分析

計算値 (C₁₂H₁₆O) C81.82%; H9.09% C81.64%; H8.89%

0.03gの2, 2-アゾピスイソプチロニトリル を5gの上記 4 ーtープトキシスチレンに溶解し た溶液を、窒素でパージした後、容器に密封し た。混合液を密封条件下で70℃に18時間加熱し た。固形物が得られ、これを塩化メチレンに溶解 し、メタノール中で沈澱させた。生成物を小片に 細断し、メタノールで洗い、減圧下80℃で12時間 乾燥した。4.76gの生成物が得られ、これは収率

12

95.2%であつた。製造法および塩化メチレン中で のGPC分析に基づいて、この生成物はMn= 181500g/モルおよびM_{*}=437000g/モルのポリ **ー4ーtーブ**トキシスチレンであつた。この<u>重</u>合

実施例 2

実施例1の手順を繰返したが、本例では16.9g (0.70モル) のマグネシウム金属および100g(0.66 モル)の4ークロローαーメチルスチレンを200 乾燥蒸留テトラヒドロフランを8.9g(0.37モル) 10 wlのテトラヒドロフランに溶解して用いた。少量 のヨウ化メチルを加えてグリニヤール反応を開始 した。反応混合物を12時間還流した後、0℃で 85gのtープチルパーペンゾエートを300mのエ チルエーテルに溶解した溶液を滴加した。 4, 60℃に0.5時間、マグネシウムの大部分が消費さ 15 4′ージイソプロペニルピフエニルと同定される結 晶生成物を油から分離し、混合物を沪過し、メタ ノールで洗つてこの油を回収した。メタノールを ストリツピングした後、分別蒸留により4ーtー プトキシーαーメチルスチレンを、沸点65-68 うな速度で加えた。添加完了後、かきまぜながら 20 ℃/0.03‱の無色の液体として収率69.3%で単離 した。

4-t-ブトキシーα-メチルスチレンのカチ オン重合を、窒素雰囲気中の密封条件下で、3.5g の4-t-プトキシ-α-メチルスチレン、1ml ウム水溶液で2回洗い、次いで水で、洗液が中性 25 の1, 2ージクロロエタンおよび0.04gの4ーメ トキシジフエニルヨードニウム ヘキサフルオロ ホスフェートで行つた。混合物を-28℃から-50 ℃に冷却し、450ワットのハノピア(Hanovia) 中圧水銀アークランプを用いて1時間照射した。 した。沸点が45-46℃/0.03mである4-t-ブ 30 照射後、粘稠な重合体混合物を-30℃で0.5時間 静置し、次いでメタノール中で沈澱させた。重合 体を沪過し、メタノールで洗い、次いで真空下で 乾燥し、M"=10173g/モルおよびM"=15495g/ モルのポリー4ーtープトキシーα-メチルスチ 35 レン0.8gを得た。

実施例 3

実施例1をすべての点について繰返したが、本 例では4ークロロスチレンの代りに3ープロモス チレンを用いた。3-t-プトキシスチレンであ る生成物を分別蒸留により精製し、沸点50-52 ℃/0.05mの純粋な単量体を次の重合に用いた。 0.36gの 2, 2ーアゾピスイソプチロニトリルと 15.0gの3-t-プトキシスチレンの混合物を窒 素下で重合フラスコに密封した。重合を70℃で18

(7)

特公 平 5-69420

13

時間行つた。重合体を実施例1に記載した通りに 単離した。

実施例 4

0.5gのポリー 4 - t - プトキシスチレン、<math>0.1g のジ(tープチルフエニル) ヨードニウム トリ 5 フルオロメタンスルホネートおよび 7 型のグライ ムよりなる溶液を、数個の直径3インチのシリコ ンウエーハにスピンコートした。次にウエーハを 100℃で30分間焼付け、次に金属接点材およびGE た。2秒間の照射後、100℃で5秒間の後焼付け を行つた。ウエーハを1.6N Na OHに 1 分間浸 漬することによりウエーハを現像した。 鮮明な輪 郭のはつきりしたポジイメージが得られた。

に基づくホトレジストを用いて、上記と同じ手順 を繰返した。最初にシリコンウエーハを5秒間照 射し、100℃で10秒間の後焼付けをし、1.6N Na OHで1分間現像することにより、ポジトーンの イメージが得られた。

実施例 5

14

0.5gのポリー 4 - t -ブトキシシチレン、0.2g のジ(4-t-ブチルフエニル) ヨードニウム ヘキサフルオロアンチモネート、0.0037gのペリ レンおよび5回のグライムを含有するホトレジス ト溶液を製造した。この溶液を直径4インチのシ リコンウエーハにスピンコートし、100℃で30分 間焼付けた。多重密度マスク付きのパーキン・エ ルマー (Perkin Elmer) 111投影アライナを用い てウエーハを露光した。n-ヘキサンとクロロホ H3T7中圧水銀アークランプを用いてプリントし 10 ルムの3:1混合液を用いて、ウエーハをネガモ ードで現像した。走査速度320で最良の結果が得 られた。1.5μmまでのラインを解像し、2.5μmの ラインで解像度良好であつた。

上述した実施例は、ホトレジスト組成物をマス ポリー4ーtーブトキシーαーメチルスチレン 15 クするのに用い得る極めて多数の変数ならびにア ルケニルアリールエーテルおよびそれから得られ る重合体のごく一部に関するものであるが、本発 明は、実施例に先立つ説明からわかるように、は るかに広い範囲のホトレジスト組成物ならびにこ 20 の組成物の製造に用いるアルケニルアリールエー テル材料に関することを理解すべきである。